Procedeu de obţinere a diodei Schottky pe bază de ZnPc, care include dizolvarea ZnPc în acid formic, agitarea ultrasonică a soluţiei timp de 30 min, dizolvarea separată a I_2 în acid formic, agitarea ultrasonică a soluţiei până la dizolvarea completă a I_2, amestecarea soluţiilor prin agitarea ultrasonică timp de 10 min, depunerea soluţiei obţinute peste substratul de ITO, acoperit cu PEDOT:PSS prin metoda depunerii în picătură sau depunerii prin centrifugare, uscarea stratului depus la temperatura camerei, depunerea contactelor de aluminiu prin evaporare termică în vid.